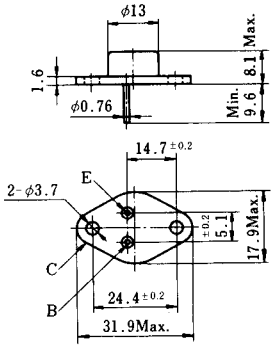
2SD256, 2SD257, 2SD258, 2SD259

■シリコンNPN両面拡散形トランジスタ

○一般用
○通信産業用
○指定通信工業用品種

外形寸法*（単位：mm）
JEDEC(TO-66), EIAJ(TC-16A, TB-23)



■最大定格（Ta＝25℃）

項　目	記　号	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60V	90V	110V	130V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	40V	60V	80V	100V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6V			
コレクタ電流	I_C	4A			
ベース電流	I_B	1A			
許容コレクタ損失	P_C	25W(フランジ温度25℃)			
接合部温度	T_j	150℃			
保存温度	T_{stg}	−65～+150℃			

www.DataSheet4U.com

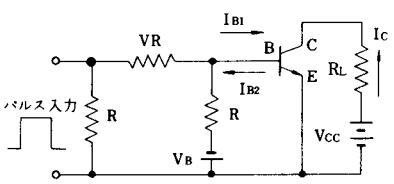
■電気的特性（Ta＝25℃）

項　目	記　号	試　験　条　件	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
最大コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB} = 20V	10μA			
最大エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB} = 5V	200μA			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	I_C = 50mA	40V	60V	80V	100V
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE} = 4V I_C = 1A	40Min. 80Typ.			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C = 2A I_B = 0.4A	1.0V Max. 0.2V Typ.			
しゃ断周波数	$f_{\alpha b}$	V_{CB} = 10V I_E = −0.2A	8MHz Typ. 4MHz Min.			

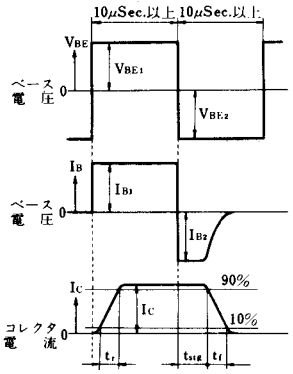
■代表的スイッチング特性（エミッタ接地）

V_{CC} (V)	R_L (Ω)	I_C (A)	I_{B1} (mA)	I_{B2} (mA)	t_r (μSec.)	t_{stg} (μSec.)	t_f (μSec.)
6	3	2	400	−100	1.2	1.6	1.7

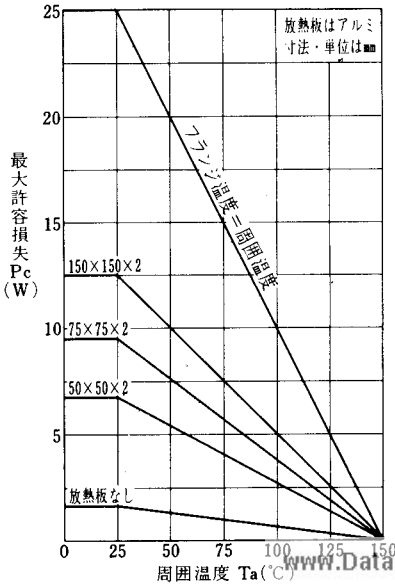
スイッチング特性測定回路



測　定　条　件



周囲温度と最大許容損失



www.DataSheet4U.com